

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Государственный завод «ПУЛЬСАР»

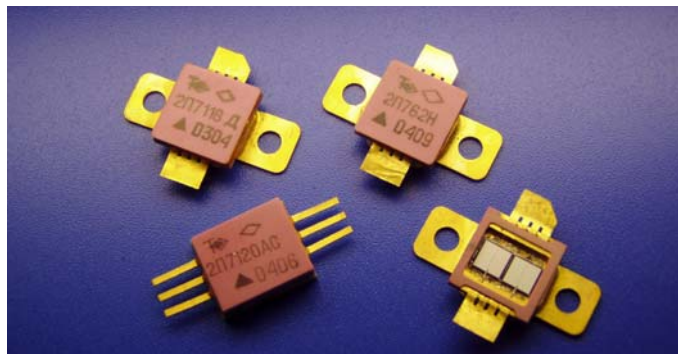


**ФГУП ГЗ
«ПУЛЬСАР»**

ФГУП ГЗ «ПУЛЬСАР»
105187, г. Москва
Окружной проезд, 27

Телефон: (495) 369-0475
E-mail: pulsar@rosprom.org
Факс: (495) 365-0668

КРЕМНИЕВЫЕ МОЩНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ МДП и БТИЗ ТРАНЗИСТОРЫ ДЛЯ ВТОРИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ И СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ



Транзисторы обладают высокими эксплуатационными характеристиками, применяются в малогабаритных вторичных источниках питания наземной и бортовой авиационной и ракетно-космической техники.

Тип изделия	$U_{си}$	$I_{с макс}$	$R_{си (откр)}$	$P_{макс}$	Корпус
	В	А	Ом	Вт	
2П701А (А842А)	500	5	3,5	40	КТ-57
2П701Б (А842Б)	400	5	2,8	40	КТ-57
2П803А (А843А)	1000	2,6	5	60	КТ-57
2П803Б (А843Б)	800	3	4,5	60	КТ-57
2П762А (А874)	100	100 (имп.)	0,085	80	КТ-57
2П762Д (А874)	150	30 (имп)	0,1	80	КТ-57
2П762Н (А874)	200	80 (имп)	0,2	80	КТ-57

Тип изделия	$U_{си макс}$	$U_{зи пор}$	$I_{с макс}/I_{с и макс}$	$R_{си (откр)}$	$I_{с нач}$	$I_{з.ут.}$	$P_{макс}$	Корпус
	В	В	А	Ом	мА	А	Вт	
2П7118А	30	1,5÷5,0	35/100	0,025	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118 Б	40	1,5÷5,0	35/100	0,035	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118 В	50	1,5÷5,0	35/100	0,04	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118 Г	60	1,5÷5,0	30/100	0,05	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118 Д	100	1,5÷5,0	30/100	0,075	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118 Е	100	1,5÷5,0	30/100	0,085	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118 Ж	150	1,5÷5,0	25/100	0,1	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118 И	150	1,5÷5,0	25/100	0,12	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118 К	200	1,5÷5,0	20/100	0,16	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118 Л	200	1,5÷5,0	20/100	0,2	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57

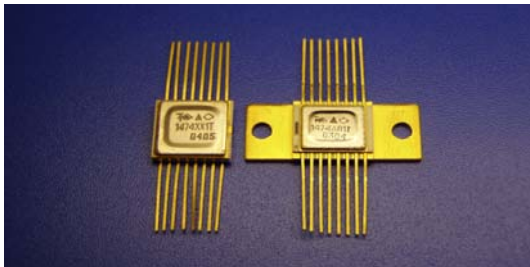
Кремниевые биполярные транзисторы с изолированным затвором (БТИЗ)

Тип изделия	U_{GES}	I_C	$U_{GE(ON)}$	$P_{макс}$	$\tau_{вкл.}$	$\tau_{выкл.}$	Корпус
	В	А	В	Вт	нсек	нсек	
2Е701А	700	25	2,5	75	200	700	КТ-57
2Е701Б	500	25	2,5	75	200	500	КТ-57
2Е701В	500	25	3,5	75	200	500	КТ-57
2Е701Г	700	25	3,5	75	200	700	КТ-57

**Транзисторная сборка кремниевых эпитаксиально-планарных полевых изолированным затвором
с изолированным затвором переключаемых транзисторов**

Тип изделия	$U_{си макс}$	$I_{з.ут.}$	$R_{си (откр) *}$	$I_{с нач}$	$U_{зи пор}$	I_c	$U_{пр.}/t_{восст.}^{**}$	Корпус
	В	А	Ом	мА	В	А	В/нс	
2П7120 АС	150	$3 \cdot 10^{-7}$	0,2	2,0	2,0	5,0	3,0/500	427.8-1
2П7120 БС	200	$3 \cdot 10^{-7}$	0,5	2,0	4,0	5,0	3,0/500	427.8-1
2П7120 ВС	150	$3 \cdot 10^{-7}$	0,2	2,0	2,0	5,0	3,0/500	427.8-1
2П7120 ГС	200	$3 \cdot 10^{-7}$	0,5	2,0	4,0	5,0	3,0/500	427.8-1
2П7120 ДС	150	$3 \cdot 10^{-7}$	0,2	2,0	2,0	5,0	3,0/50	427.8-1
2П7120 ЕС	200	$3 \cdot 10^{-7}$	0,5	2,0	4,0	5,0	3,0/50	427.8-1

**ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ СЕРИИ 1474
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ СИЛОВЫХ ТРАНЗИСТОРНЫХ КЛЮЧЕЙ**



Область применения: интеллектуальная силовая электроника специального и общегражданского применения (устройства промышленной автоматики, преобразования и распределения электроэнергии, источники питания, приводы электродвигателей, бытовая техника)

ИМС типа 1474АП1Т предназначены для управления силовыми транзисторными ключами (СТК) на основе МДП и БТИЗ.

Основные особенности:

двухполярное напряжение питания, что позволяет эффективно управлять силовыми ключами на МДП и БТИЗ;

возможность введения регулируемой задержки включения, что исключает возникновение сквозных токов в мостовых и полумостовых регуляторах и преобразователях;

наличие трех управляющих входов (потенциального, токового и оптронного);

наличие внутреннего реле напряжения питания, что обеспечивает надежную эксплуатацию силовых модулей;

микросхема «активно» удерживает выходной потенциал на низком уровне, даже при отсутствии питания, что обеспечивает безопасность переходных режимов «включение и выключение силовых модулей».

Конструктивно ИМС 1474АП1Т выполнены в металлокерамическом корпусе 402.16-34, возможна поставка микросхем в корпусе 4112.16-3 и в бескорпусном исполнении – модификация 4 ОСТ В 11 073.067-82.

Электрические параметры ИМС 1474АП1Т

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
1. Выходное напряжение высокого уровня, В	U_{OH}	8	U_{CC1}
2. Выходное напряжение низкого уровня, В	U_{OL}		1
3. Входное напряжение включения драйвера (по потенциальному входу), В	U_{IH}	2,5	15
4. Входное напряжение выключения драйвера (по потенциальному входу), В	U_{IL}		0,5
5. Входной ток включения драйвера (по токовому входу), мА	I_{IH}	1,5	2,5
6. Входной ток выключения драйвера (по токовому входу), мА	I_{IL}		0,1
7. Средний статический ток потребления, мА	I_{CCAV}		15
8. Время нарастания (спада) выходного напряжения, нс при $C_L = 12000$ пФ $R_L = 1,0$ Ом (послед.) - при однополярном питании - при двухполярном питании	$t_r(t_f)$		150 200
9. Время задержки включения (выключения), нс при $C_L = 12000$ пФ, $R_L = 1,0$ Ом	$t_{DHL}(t_{DLH})$		70

Возможна поставка комплектами:

Мощные МДП и БТИЗ транзисторы и микросхемы управления типа 1474.